

中信建投证券股份有限公司

关于拓荆科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告

保荐人名称：中信建投证券股份有限公司	被保荐公司名称：拓荆科技股份有限公司
保荐代表人姓名：胡明勇	联系方式：010-56051846 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层
保荐代表人姓名：刘恺伦	联系方式：010-56051854 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 11 层

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人”）作为拓荆科技股份有限公司（以下简称“拓荆科技”、“公司”）2025 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具 2026 年半年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	保荐机构、保荐代表人应当协助和督促上市公司建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，以符合法律法规和本规则的要求，并确保上市公司及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员、核心技术人员知晓其在本规则下的各项义务。	保荐人、保荐代表人已协助和督促拓荆科技建立相应的内部制度、决策程序及内控机制，符合相关法律法规的要求。2026 年 1-6 月，拓荆科技无控股股东、实际控制人。拓荆科技及其董事、高级管理人员、核心技术人员已知晓其在相关规则下的各项义务。
2	保荐机构、保荐代表人应当持续督促上市公司充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，并确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐机构、保荐代表人应当对上市公司制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。 保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司控股股东、实际控制人履行信息披露义务，告知并督促其不得要求或者协助上市公司隐瞒重要信息。	2026 年 1-6 月，拓荆科技无控股股东、实际控制人。 保荐人、保荐代表人已持续督促拓荆科技充分披露投资者作出价值判断和投资决策所必需的信息，拓荆科技信息披露真实、准确、完整、及时、公平。 保荐人、保荐代表人已对拓荆科技制作信息披露公告文件提供必要的指导和协助，确保其信息披露内容简明易懂，语言浅白平实，具有可理解性。
3	上市公司或其控股股东、实际控制人作出承诺的，保荐机构、保荐代表人应当督促其对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露。	2026 年 1-6 月，拓荆科技无控股股东、实际控制人。 保荐人、保荐代表人已督促拓荆科技对承诺事项的具体内容、履约方式及时间、履约能力分析、履约风险及对策、

序号	工作内容	持续督导情况
	保荐机构、保荐代表人应当针对前款规定的承诺披露事项，持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促相关主体及时、充分履行承诺。 上市公司或其控股股东、实际控制人披露、履行或者变更承诺事项，不符合法律法规、本规则以及本所其他规定的，保荐机构和保荐代表人应当及时提出督导意见，并督促相关主体进行补正。	不能履约时的救济措施等方面进行充分信息披露；已持续跟进相关主体履行承诺的进展情况，督促其及时、充分履行承诺；未发现上市公司披露、履行或者变更承诺事项存在不符合法律法规及其他相关规定的情形。
4	保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。	保荐人、保荐代表人已督促拓荆科技积极回报投资者，建立健全并有效执行符合公司发展阶段的现金分红和股份回购制度。
5	保荐机构、保荐代表人应当持续关注上市公司运作，对上市公司及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料、列席股东会等方式，关注上市公司日常经营和股票交易情况，有效识别并督促上市公司披露重大风险或者重大负面事项。 保荐机构、保荐代表人应当核实上市公司重大风险披露是否真实、准确、完整。披露内容存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，保荐机构、保荐代表人应当发表意见予以说明。	2026年1-6月，保荐人、保荐代表人持续关注拓荆科技运作，对拓荆科技及其业务有充分了解；通过日常沟通、定期回访、调阅资料等方式，关注拓荆科技日常经营和股票交易情况。2026年1-6月，拓荆科技不存在应披露而未披露的重大风险或者重大负面事项。
6	上市公司股票交易出现严重异常波动的，保荐机构、保荐代表人应当督促上市公司及时按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》履行信息披露义务。	2026年1-6月，拓荆科技股票交易未出现严重异常波动。
7	保荐机构、保荐代表人应当督促控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。	2026年1-6月，拓荆科技无控股股东、实际控制人。保荐人、保荐代表人已督促拓荆科技第一大股东、董事、高级管理人员及核心技术人员履行其作出的股份减持承诺，并持续关注前述主体减持公司股份是否合规、对上市公司的影响等情况。
8	保荐机构、保荐代表人应当关注上市公司使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。	保荐人、保荐代表人已关注拓荆科技使用募集资金的情况，督促其合理使用募集资金并持续披露使用情况。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

在本持续督导期间，保荐人和保荐代表人未发现拓荆科技存在重大问题。

三、重大风险事项

在本持续督导期间，公司主要的风险事项如下：

（一）核心竞争力风险

随着半导体行业技术的发展和迭代，下游客户对半导体设备种类及性能的需求也随之变化。因此，公司需要持续保持较高的研发投入，保持产品的核心竞争力和先进水平。如果公司未来未能准确理解下游客户的产线设备及工艺技术演进需求，或者技术创新产品不能契合客户需求，可能导致公司设备无法满足下游产线生产制造需要，将可能对公司的经营业绩造成不利影响。

（二）经营风险

1、产品验收周期较长风险

薄膜沉积设备所制备薄膜的技术参数是影响芯片最终性能表现的核心要素之一。在生产流程中，晶圆厂不仅需要在薄膜成型后对厚度均匀性、光学特性、机械应力、颗粒缺陷等关键指标进行检测，还需要在完成全流程晶圆制造与芯片封装后，对终端产品开展可靠性与全生命周期测试，以此验证薄膜沉积设备是否满足量产技术要求，这一完整验证过程使得晶圆厂对该类设备的导入验证周期普遍较长。同时，公司面向三维集成领域开发的先进键合设备属于高精度专用制造装备，目前已实现百纳米级键合精度，该技术是高带宽存储器（HBM）、三维闪存芯片、3D DRAM、异构集成芯片等先进芯片产品制造的核心支撑，当前整体仍处于产业化初期阶段。由于该设备在部分下游应用场景中尚未完成规模化验证，若下游定制化开发需求超出预期，将可能带来技术开发风险，导致公司研发投入超预期增长、产品验证周期延长，进而使得公司收入确认与货款回收周期延后，加大资金周转压力，对公司财务稳健性构成潜在影响。

2、市场竞争风险

半导体设备行业具有很高的技术壁垒和市场壁垒。目前公司的竞争对手主要为国际知名半导体设备制造商，由于半导体产线对于设备技术水平、稳定性、设备间配合度要求极高，因此半导体设备的验证周期与导入周期一般较长，与中国大陆半导体专用设备厂商相比，国际领先制造商往往在客户端具备一定先发优势；此外，存在国内潜在竞争对手进入本行业参与竞争的可能性，引起行业竞争格局的变化。尽管公司的产品工艺覆盖面与核心技术目前具备较大的领先地位与竞争优势，但若无法有效应对市场竞争环境、维持技术创新迭代能力并保持产品竞争优势，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能会受到一定影响。

3、下游客户扩产不及预期的风险

下游客户扩产规模决定了半导体专用设备的市场空间。晶圆厂的扩产投资具有一定的周期性。如果下游晶圆厂的投资强度降低，公司将面临市场需求下降的风险，对于公司的经营业绩会造成不利影响。

4、供应链安全风险

近年来，复杂的国际形势加剧了全球供应链的不稳定性。目前，公司仍然与部分零部件的海外供应商保持合作关系。如果国际贸易摩擦进一步加剧，可能出现上述国外供应商受相关政策影响减少或者停止对公司部分零部件的供应，可能会影响公司产品生产能力、生产进度和交货时间，降低公司的市场竞争力。

（三）财务风险

2026 年 1-6 月，公司享受高新技术企业所得税及国家关于集成电路领域的相关税收优惠政策，如果国家上述税收优惠政策发生变化，则可能面临因税收优惠减少或取消而降低盈利的风险。

（四）行业风险

近年来，受下游新兴需求不断涌现、客户资本性支出增加、芯片结构及制造工艺不断迭代等因素影响，国内半导体设备市场需求整体呈持续增长趋势。但由于半导体行业受国际经济波动、下游产业发展进度、终端消费市场需求变化等方面影响较大，其发展往往呈现一定的周期性波动特征。在半导体行业上行周期中，半导体芯片制造厂往往加大资本性支出，快速提升对半导体设备的需求；若未来半导体行业处于下行周期中，半导体芯片制造厂往往会削减资本性支出，减少对半导体设备的需求。前述宏观环境及行业波动造成的半导体设备需求波动，可能会为公司的业务发展和经营业绩带来一定波动性风险。

（五）宏观环境风险

当前全球经济增长承压，叠加地缘政治冲突、关税政策变化加剧，可能影响半导体行业发展增速、供应链安全及终端市场需求，继而影响半导体设备行业整体需求。

四、重大违规事项

在本持续督导期间，拓荆科技不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据如下所示：

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增 减增减（%）
营业收入	2,912,864,261.46	1,954,146,173.65	49.06
利润总额	1,387,633,306.09	81,537,056.02	1,601.84
归属于上市公司股东的净利润	1,342,753,980.93	94,287,965.15	1,324.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	367,334,974.63	38,187,705.25	861.92
经营活动产生的现金流量净额	115,460,241.35	1,566,015,443.91	-92.63
主要会计数据	2026 年 6 月 30 日	2025 年 6 月 30 日	本期末比上年同期 期末增减增减 （%）
归属于上市公司股东的净资产	12,715,699,579.42	6,609,957,217.37	92.37
总资产	25,312,149,848.91	19,823,566,917.19	27.69

2026 年 1-6 月，公司主要财务指标如下表所示：

主要会计数据	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	本期比上年同期增 减增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	4.77	0.34	1,302.94
稀释每股收益（元 / 股）	4.70	0.33	1,324.24
扣除非经常性损益后的基本 每股收益（元 / 股）	1.31	0.14	835.71
加权平均净资产收益率 （%）	18.11	1.76	增加 16.35 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%）	4.95	0.71	增加 4.24 个百分点
研发投入占营业收入比例 （%）	14.52	17.87	减少 3.35 个百分点

2026 年 1-6 月，公司主要财务数据及指标变动的原因如下：

1、2026 年 1-6 月，公司实现营业收入 29.13 亿元，同比增长约 49.06%，主要原因如下：公司始终坚持自主创新，并持续加大力度推进先进制程领域的新产品、新工艺的拓展与量产应用，2026 年 1-6 月，公司先进产品凭借高质量、高性能的优异表现，批量通过了客户验证，致公司业务规模和收入快速增长。其中，公司 PECVD 系列设备产品以良好的稳定性、高产能及优异的薄膜工艺指标等特点持续保持竞争优势，不断扩大量产规模，尤其是应用于先进存储、先进逻辑等领域的 PECVD Stack（ONO 叠层）、ACHM 系列工艺等产品已进入规模化量产阶段，批量通过客户验证，同时，OPN、SiB 及 PECVD Bianca 等产品不断扩大量产规模，并实现收入转化；公司 ALD 系列设备产品在先进存储领域量产规模快速攀升，多台 PE-ALD SiO₂、SiCO 等工艺设备在客户端完成重复订单验证，并实现收入转化。

2、2026 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.43 亿元，同比增长 1,324.10%，主要系：（1）营业收入实现大幅增长，较上年同期增加约 9.59 亿元，同比增长 49.06%。营业成本随营业收入同步增长，较上年同期增加约 3.89 亿元，同比增长 29.24%，增幅低于营业收入，主要系公司生产规模效应逐步释放，叠加新产品、新工艺设备已实现量产应用，有效降低了产品单位生产成本。受上述因素影响，公司毛利较上年同期增加约 5.70 亿元，毛利率同比提升约 9 个百分点，整体产品盈利能力显著增强；（2）业务规模化带动整体期间费用率同比有所下降，规模效应持续释放利润空间；（3）公司交易性金融资产产生的公允价值变动收益较上年同期增加约 9.60 亿元。

3、2026 年 1-6 月，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.67 亿元。公司业务规模与营业收入快速增长，毛利率同比增加，产品盈利水平得到提升，进而推动公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 861.92%。

4、2026 年 1-6 月，公司经营现金流稳定，经营活动产生的现金流量净额为 1.15 亿元，同比减少 92.63%，主要系：（1）因公司与客户约定的付款条件及履行情况不同，致销售回款阶段性降低；（2）公司业务增长带来的采购付款及支付的各项税费增加；（3）公司人员增长导致支付的职工薪酬增加。

六、核心竞争力的变化情况

公司长期专注于高端半导体专用设备的研发与产业化，始终坚持自主创新，持续为半导体行业 and 客户提供具有竞争力的产品。公司在战略布局、研发能力、技术水平、产品覆盖、客户资源、人才队伍建设、供应链稳定等方面形成竞争优势，具体体现为：

（一）战略定位明确，围绕自身发展战略稳步推进产业布局

公司自设立时便确定了聚焦高端半导体薄膜沉积设备领域这一战略定位，并持续围绕国家战略方向、市场前沿技术、行业发展趋势及客户应用需求等方向进行前瞻性布局，在巩固薄膜沉积设备优势的基础上，面向后摩尔时代技术迭代方向，公司于 2018 年即开始布局三维集成设备产品并取得了显著成果，形成“薄膜沉积+三维集成”的产品格局。公司目前已形成 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 等薄膜沉积设备产品，以及晶圆对晶圆混合键合、晶圆对晶圆熔融键合、芯片对晶圆混合键合、芯片对晶圆熔融键合等三维集成设备产品，已广泛应用于先进存储、先进/成熟逻辑、先进封装、功率器件、Micro-OLED、硅光技术、图像传感器（CIS）等领域。

公司以“建立世界领先的半导体设备公司”为愿景，通过在薄膜沉积设备领域、三维集成领域的技术积累和快速发展，已经成为国内半导体设备行业的领军企业。同时，公司遵循战略方向稳步扩张，持续深耕现有核心赛道，推动在薄膜沉积设备和三维集成设备领域的纵深发展，并前瞻性布局前沿技术赛道，提前抢占行业未来发展制高点，稳步推进横向发展，适时进行产业链整合与业务延伸，不断提升综合竞争力与行业影响力。

（二）自主研发能力突出，支撑产业链协同创新

公司始终坚持自主创新研发，以国家战略方向、前沿技术趋势及客户应用需求为导向开展研发工作，实现薄膜沉积设备和三维集成设备的全研发环节覆盖，在硬件设计、工艺开发和系统集成等多方面，实现了核心技术自主可控。凭借深厚的整机装备自主研发经验和技術积累，公司保证了较高的研发自主性和灵活性，面向客户先进制程工艺需求，能够快速实现先进产品技术研发，并高效完成研发阶段向生产阶段的快速转化，及时响应下游的供货需求。

公司的研发战略为“紧跟产业趋势、产品提前布局”，围绕先进制程和后摩尔时代带来的技术迭代需求，进行超前于当前制造节点技术代际的前瞻性基础研究与工艺开发，提前构筑技术壁垒。在此基础上，公司基于自身技术优势，与芯片制造厂在设备选型阶段即与客户开展协同式研发，精准适配客户特定工艺材料、特定制造工序的薄膜性能要求，实现常态化互动与协同创新。公司可以结合客户特定需求，提供定制化、适配度高的解决方案，既满足了下游芯片制造厂快速扩充产能的需求，也通过持续的技术迭代，配合客户实现技术升级。此外，公司先后承担多项国家重大专项/课题，整合产业资源参与技术攻坚，形成了覆盖研发、生产、供应各环节的协同创新体系，支撑产业链整体技术水平提升。

（三）核心技术领先，工艺应用覆盖全面

公司自成立以来，持续深耕高端半导体设备领域，形成了一系列具有自主知识产权的核心技术，并达到国际先进水平。公司的核心技术广泛应用于主营业务产品中，在薄膜沉积设备领域，涵盖了先进薄膜工艺设备设计技术、反应模块架构布局技术、半导体制造系统高产能平台技术、等离子体稳定控制技术，解决了半导体制造中纳米级厚度薄膜均匀一致性、薄膜表面颗粒数量少、快速成膜、设备产能稳定高速等关键难题，在保证实现薄膜工艺性能的同时，通过设计定制化高产能平台，提升设备的生产效率，进而提升客户产线的产能，减少客户产线的生产成本。此外，公司面向三维集成领域应用，形成了载片与器件晶圆高速高精度对准技术、晶圆级键合实时对准技术、芯片拾取与键合技术，实现较高的晶圆键合精度，并大幅提高设备产能。

公司通过自主研发，形成了一系列独创性的设计，构建了完善的知识产权体系并取得了多项自主知识产权。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 2,245 项（含 PCT），获得授权专利 791 项，其中发明专利 416 项。

公司依托自主核心技术体系，构建了完善的产品矩阵，在所聚焦的产品系列中实现工艺全面、深度的覆盖，量产设备产品性能达到了国际同类设备先进水平，并持续迭代升级，快速响应客户先进技术需求。在薄膜沉积设备领域，推出了 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD 为核心的全系列薄膜沉积设备，其中，PECVD 设备已实现薄膜材料的全面覆盖，在集成电路逻辑芯片、存

储芯片等领域广泛应用；在 ALD 设备方面，推出了等离子体增强原子层沉积（PE-ALD）和热处理原子层沉积（Thermal-ALD）设备并实现量产，目前国内装机量及工艺覆盖均领先；HDPCVD、SACVD、Flowable CVD 设备可实现芯片内不同深浅三维结构的填充需求，已在多条产线实现产业化应用。在三维集成设备领域，推出的混合键合设备、熔融键合设备等系列产品已成功应用于先进存储、图像传感器等领域，可以为后摩尔时代技术发展提供支撑。

（四）国内领先的行业地位及丰富的客户资源优势

公司已构建较为完善的薄膜沉积设备、三维集成设备的产品矩阵，并实现国产化突破与规模化应用。薄膜沉积设备方面，公司凭借优异的产品性能表现持续获得客户订单，不断扩大量产规模。截至 2026 年 6 月 30 日，公司产品已进入约 100 条芯片制造厂生产线；累计出货反应腔已超过 3,800 个，且应用于先进制程领域的高性能反应腔占比不断提高；在客户端产线生产产品的累计流片量达到约 6 亿片；客户端设备平均稳定运行时间（Uptime）超过 90%（达到国际主流水平）。此外，在三维集成设备方面，公司推出多款核心产品并陆续推向市场，部分已通过客户验证并进入稳步放量阶段，是国内先进混合键合设备领域技术领先厂商。

公司产品已进入逻辑芯片、存储芯片、先进封装等领域，实现主流芯片制造厂的深度覆盖与批量供货，适配从成熟制程到先进制程的工艺应用需求。公司与客户的合作模式已从单纯的设备供应升级为“协同研发+定制化适配+长期服务”的深度绑定模式，合作关系呈现稳定性强、覆盖面广、协同深入的特点，构建了可持续的客户生态体系。

（五）拥有优秀的技术研发及管理团队

公司已构建起一支兼具国际视野与产业深度的高端半导体专用设备技术研发及管理团队，通过“外部引智+内部育能”双轮驱动，形成了稳定、高效且具备创新活力的人才梯队，为技术突破与产品迭代提供核心支撑。

在人才梯队建设方面，公司构建了完善的人才引进和培养体系。一方面，通过长效股权激励机制、市场化薪酬福利与清晰的职业发展路径，持续吸引行业内的资深人才，其在整机设计、工艺开发、系统控制、软件迭代等关键领域的技术积累，有力带动研发团队实现产品创新；另一方面，公司自成立以来始终重视本

土科研团队自主培养，伴随 PECVD、ALD、SACVD、HDPCVD、Flowable CVD、三维集成设备等核心产品从研发到量产的全周期历练，本土团队已成长为技术攻坚的中坚力量。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员规模达 856 人，占员工总数的 41.78%，形成覆盖半导体设备研发全环节的学科布局。其中，博士研究生 84 人，占研发人员的 9.81%，硕士研究生 490 人，占研发人员的 57.24%，团队成员兼具扎实的专业知识储备与丰富的产线验证经验，在技术研发、工艺优化等环节分工明确、协同高效，保障成熟产品稳定迭代与先进产品的前瞻性技术研发。

2026 年 1-6 月，公司核心技术团队稳定，为技术研发的连续性与产品创新的持续性提供了坚实保障。

（六）建立起稳定供应链生态

公司建立了完善的供应链管理体系，吸纳积累全球半导体行业内的优质供应链资源，关键零部件采用“多源采购”模式，并与核心供应商建立长期战略合作关系，确保关键部件的及时稳定供应。在此基础上，公司与供应商构建了协同创新机制，在开展新产品、新技术开发过程中保持与供应商的深度协作，确保部件产品性能达到公司先进需求，形成稳定的、互信的、共赢的供应链生态。这一体系为公司产品研发、量产交付与持续创新提供了可靠保障。

七、研发支出变化及研发进展

2026 年 1-6 月，公司研发投入总额 42,280.92 万元，较上年同期增加 21.09%，其中 2026 年 1-6 月资本化研发投入金额为 7,915.51 万元，研发投入资本化比重 18.72%。

公司始终在高端半导体专用设备领域深耕，并专注于薄膜沉积设备及三维集成设备的研发与产业化，拥有多项自主知识产权和核心技术。截至 2026 年 6 月 30 日，公司累计申请专利 2,245 项（含 PCT），获得授权专利 791 项。2026 年 1-6 月，公司新增申请专利 105 项（含 PCT）、新增获得专利 87 项。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）2022 年首次公开发行股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，公司 2022 年首次公开发行股票募集资金专户余额为 14,834.18 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2022 年首次公开发行股票募集资金
募集资金到账时间	2022 年 4 月 14 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
一、募集资金总额	227,283.12
其中：超募资金金额	112,730.08
减：直接支付发行费用	14,523.40
二、募集资金净额	212,759.73
减：	
以前年度已使用金额	190,551.93
本报告期使用金额	14,566.91
银行手续费支出	2.06
加：	
募集资金利息收入	7,195.35
三、报告期期末募集资金余额	14,834.18

注：本持续督导跟踪报告中部分合计数与各明细数直接相加减在尾数上如有差异，若无特殊说明，相关差异均是由于四舍五入造成的。

（二）2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金

截至 2026 年 6 月 30 日，2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专户余额为 456,342.47 万元，具体情况如下：

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
募集资金到账时间	2026 年 6 月 17 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

项目	金额
一、募集资金总额	459,999.97
减：直接支付发行费用	4,174.73
二、募集资金净额	455,825.24
减：	
银行手续费支出	0.04
加：	
募集资金利息收入	2.54
加：	
尚未从专户支付出去的发行费用	514.73
三、报告期期末募集资金余额	456,342.47

公司 2026 年 1-6 月募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2026 年 1-6 月，公司无控股股东、实际控制人。公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员持有公司股票情况及 2026 年 1-6 月期间所持股份的增减变动情况如下表所示：

单位：股

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	2026 年 1-6 月股份增减变动量	增减变动原因
刘静	董事、总经理	90,472	192,148	101,676	公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属
宁建平	副总经理、核心技术人员	28,752	74,336	45,584	公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	2026年1-6月股份增减变动量	增减变动原因
					2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
陈新益	副总经理、核心技术人员	30,608	76,192	45,584	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
牛新平	副总经理、核心技术人员	24,856	64,964	40,108	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
许龙旭	副总经理	29,571	67,044	37,473	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
赵曦	副总经理、董事会秘书	48,290	107,564	59,274	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
杨小强	财务负责人	8,662	27,073	18,411	公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属以及2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属
孟亮	核心技术人员	4,300	2,200	-2,100	个人减持
杨家岭	核心技术人员	23,704	18,534	-5,170	个人减持
邓浩	核心技术人员	0	476	476	2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属及个人减持

截至2026年6月30日，公司现任董事、高级管理人员、核心技术人员持有的公司股份不存在质押、冻结情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具日，不存在保荐人认为应当发表意见的其他事项。

（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于拓荆科技股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

胡明勇

胡明勇

刘恺伦

刘恺伦

中信建投证券股份有限公司

2026 年 9 月 8 日

